

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им.

А.Ф. Иоффе Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности

старшего научного сотрудника, кандидата наук

в лаборатории фотоэлектрических преобразователей

Вакансия VAC 95192

Тематика исследований

Исследования и разработка полупроводниковых фотоэлектрических приборов и разработка технологий эпитаксиального роста A3B5 гетероструктур методом газо-фазной эпитаксии из металлорганических соединений.

Трудовая деятельность

Проведение научных исследований и разработок полупроводниковых A3B5 гетероструктур и фотопреобразователей на их основе с применением метода газо-фазной эпитаксии из металлорганических соединений, изучение и анализ гетероструктурных свойств полупроводниковых структур, оптических и фотоэлектрических характеристик приборов. Разработка планов исследований, сбор, изучение и обобщение полученных научно-технических данных, проверка достоверности результатов, полученных другими сотрудниками, непосредственное участие в выполнении исследований и разработки научно-технических решений по сложным проблемам в области эпитаксиальной технологии и физики полупроводниковых гетероструктур и фотоэлектрических приборов. Инициирование и подготовка публикаций результатов научно-исследовательских работ в российских и зарубежных журналах, а также представление этих результатов на российских и международных конференциях по тематике исследований. Подготовка заявок на проекты научно-исследовательских работ, участие в повышении квалификации научных кадров.

Требование к претенденту

- кандидат физико-математических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников;
- наличие не менее 100 публикаций в рецензируемых научных изданиях (в т.ч. не менее 20 – в изданиях первого и второго квартилей WoS/Scopus) за последние 5 лет, участие с докладами на российских и международных конференциях, участие в НИР по проектам российских фондов, хозяйственным договорам и программам министерств и ведомств РФ (не менее 15 за последние 5 лет);
- научно-метрические показатели: индексы Хирша по WoS и Scopus DB – не ниже 13; наличие результатов интеллектуальной деятельности за последние 5 лет;
- опыт научной деятельности: не менее 15 лет. Опыт работы и проведение технологических процессов на эпитаксиальном оборудовании газофазной эпитаксии и, в частности, на оборудовании AIXTRON (в.т.ч. AIX200/4, AIX2600G3, AIX2800G4), а также умение составлять программы автоматизации процессов эпитаксиального роста. Высокий уровень знания принципов работы и технологии формирования эпитаксиальных гетероструктур фотоэлектрических преобразователей различного типа (в том числе многопереходных фотопреобразователей на основе A3B5 полупроводников и Ge).

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 31 395 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 15 000 руб.

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.